

产品介绍

YMX23-75110C1 是一款 W 波段宽带混频器芯片，频率范围覆盖75GHz~110GHz，变频损耗典型值为 9dB，本振-射频隔离度典型值为 20dB，射频输入 P1dB 为 3dBm。只能实现下混频。

关键技术指标

- RF/LO 频率范围：75GHz~110GHz
- IF 频率范围：DC~12GHz
- 变频损耗：9dB(典型值)
- LO-RF 隔离度：20dB(典型值)
- 射频输入 P1dB：3dBm
- 本振驱动功率：8dBm
- 直流供电：Vg=-0.5V
- 芯片尺寸：1.20 mm×1.10 mm×0.07 mm

应用领域

- 雷达
- 通信
- 仪器仪表



电性能表 (V_g=-0.5V, LO=7dBm, T_A=+25°C)

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率范围	75		110	GHz
本振频率范围	75		110	GHz
中频频率范围	DC		12	GHz
SSB变频损耗	8.5	9	11	dB
本-射隔离度	16	20	26	dB
射频输入P1dB		3		dBm
本振功率	5	8	13	dBm
射频端口驻波	1.1	1.2	1.3	-
中频端口驻波	1.1	1.4	1.7	-

使用限制参数

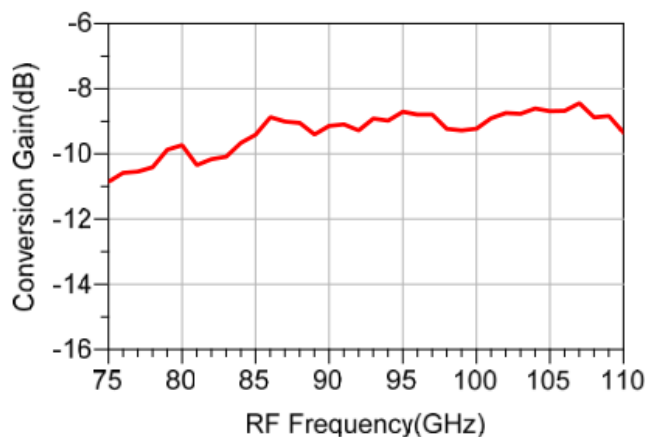
射频输入功率	10dBm
本振输入功率	15dBm
栅极负电压	-1V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

在片测试曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)

Freq_IF=1GHz , Freq_IF=Freq_RF-Freq_LO ;

Pwr_RF=-10dBm , Pwr_LO=8dBm , Vg=-0.5V

SSB变频损耗 vs.射频频率

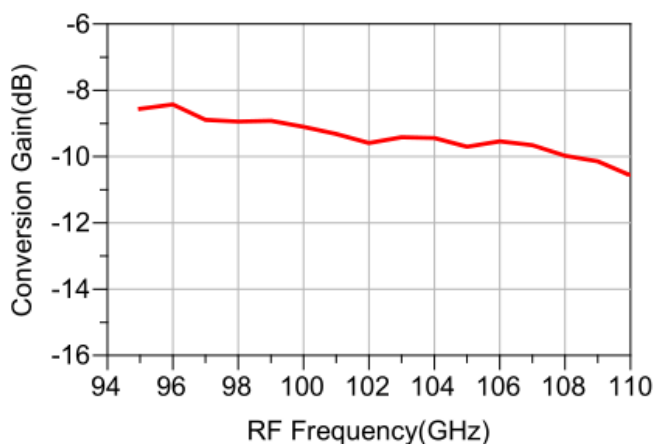


在片测试曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)

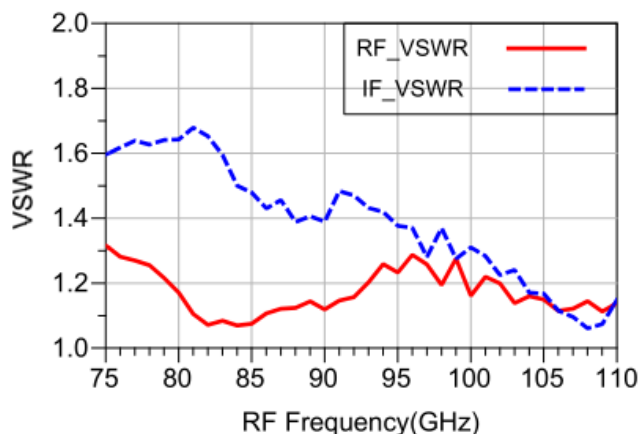
Freq_LO=94GHz , Freq_IF=Freq_RF-Freq_LO ;

Pwr_RF=-10dBm , Pwr_LO=8dBm , Vg=-0.5V

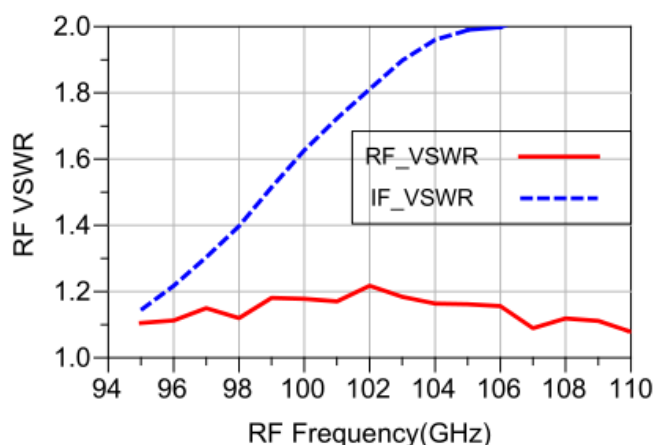
SSB变频损耗 vs.射频频率



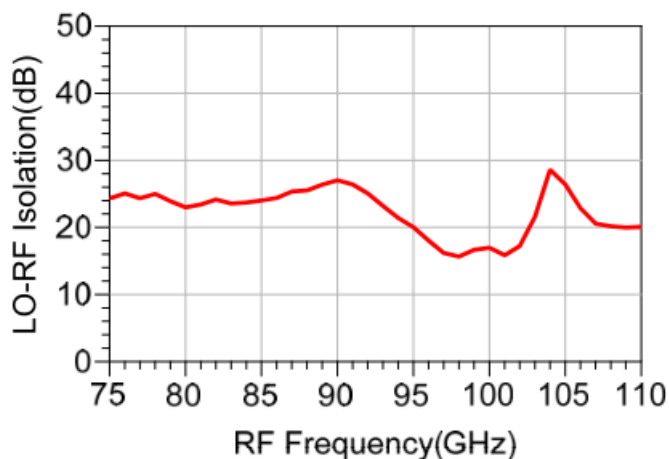
射频/中频驻波 vs.射频频率



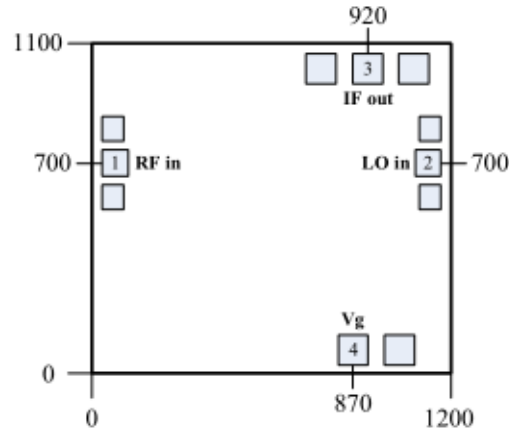
射频/中频驻波 vs.射频频率



本振-射频隔离度 vs.本振频率



外形尺寸



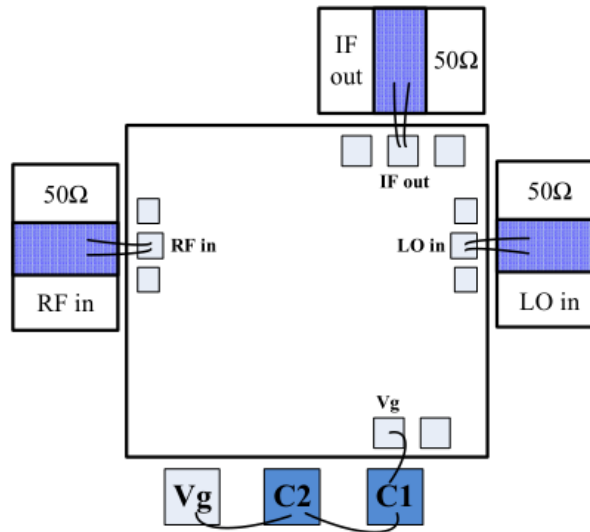
注:

- 1) 所有标注尺寸单位为微米 (μm) ;
- 2) 外形长款尺寸公差: $\pm 50\mu\text{m}$;
- 3) 芯片厚度 $70\mu\text{m}$ 。

键合压点定义

编号	符号	功能描述	尺寸 (μm^2)
1	RF in	射频信号输入端, 外接 50 欧姆系统, 无需隔直电容。	80 x 80
2	Lo in	本振信号输入端, 外接 50 欧姆系统, 无需隔直电容。	80 x 80
3	IF out	中频信号输出端, 外接 50 欧姆系统, 片上无隔直电容。	100 x 100
4	Vg	栅极电压馈电端, 需外置 100pF 和 10000pF 旁路电容。	100 x 100

建议装配图



注：外围电容 C1 容值为 100 pF，C2 容值为 10000 pF，其中C1 推荐使用单层电容，并尽量靠近芯片键合压点。

定义

极限值定义

极限值是根据绝对最大额定值系统 (IEC 60134) 给出的。压力高于一个或多个极限值，会造成对该产品的永久性损坏。这些是压力额定值，并且以这些额定值或者其它任何高于规定额定值的条件去操作器件将得不到任何保证。长时间的极限值操作可能会影响产品的可靠性。

使用方法

在此描述的产品的使用方法仅起说明作用。在没有进一步测试或修正的情况下，益丰不作任何陈述或保证：这些使用方法将适用于特定用途。

免责声明

生命保障类应用

这些产品并非为生命保障应用、器件或系统而设计的，因此，这些产品的故障可能会导致人身伤害。

若益丰的客户在生命保障类应用中使用或销售这些产品，应自担风险，并同意全部赔偿此类应用给益丰公司造成的任何损失。

修改权限

益丰公司持有对产品做出修改的权利，恕不另行通知，修改包括对电路、标准单元或软件进行设计或性能修改。除非另有说明，益丰公司对这些产品的使用不承担任何责任或义务，不在任何专利、版权、或侵权下转让许可或权利，也不会做出任何陈述或保证：这些产品不受专利、版权或侵权限制。

采购信息

编号	封装	版本	分类	描述
YMX23-75110C1	裸芯片	C1	MMIC	75 – 110 GHz 平衡混频器